

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО ГОРЕНИЯ В ПЛАЗМЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ

*Н.В.Зимиренко, С.П.Курдюмов, А.П.Михайлов,
А.А.Самарский*

Показано, что в рамках плоской геометрии процесс зажигания термоядерного горения в D + T плазме при учете электронной теплопроводности и локального поглощения α -частиц может сопровождаться локализацией горения на определенных участках среды в течение конечного промежутка времени. Указаны величины размера и амплитуды начальных возмущений температуры, приводящих к резонансному возбуждению горения. Даны масштабы размера и времени развития структуры термоядерного горения.

В рамках плоской геометрии и модели среды, учитывающей электронную теплопроводность и локальное поглощение α -частиц, рассмотрены особенности зажигания термоядерного горения (ТГ) в D + T-плазме. Показано, что этот процесс может сопровождаться локализацией горения на определенных участках среды в течение конечного промежутка времени, а его возбуждение носит резонансный характер и зависит от амплитуды и размера начального возмущения температуры.

1. Распространение волны ТГ изучалось в [1 - 3]. В данной работе рассмотрена начальная стадия горения, вызванного возмущением температуры конечной амплитуды. В мишнях, используемых в ЛТС, это возмущение создается, как показывают расчеты на ЭВМ, первоначальной УВ и дальнейшим нагревом вещества при его почти адиабатическом сжатии [1, 4, 5].

Будем пренебречь выгоранием DT-материала и процессами переноса излучения и рассматривать плазму как однотемпературную, идеальную и неподвижную среду. Справедливость допущений будет проверена ниже.

Для сечения реакции $\langle\sigma v\rangle_{DT}$ используется выражение из [6], справедливое в диапазоне $1 \lesssim T \lesssim 30 \text{ кэв}$. Тогда для полностью ионизованной плазмы с равными концентрациями D и T процесс зажигания описывается уравнением

$$\frac{\partial T}{\partial t} = k_0 \frac{\partial}{\partial r} \left(T^\sigma \frac{\partial T}{\partial r} \right) + \frac{q_0 T^\beta}{1 + BT^b} \quad (1)$$

где T (кэв) — температура; $k_0 T^\sigma$ — коэффициент электронной температуропроводности, $k_0 = 8,1 \cdot 10^{-3} \rho^{-1} \text{ см}^2 \text{ сек}^{-1} \text{ кэв}^{-2.5}$, $\sigma = 2.5$; $q_0 = 4.7 \cdot 10^5 \rho \text{ сек}^{-1} \text{ кэв}^{-4.2}$, $\beta = 5.2$, $B = 2.4 \cdot 10^{-3} \text{ кэв}^{-3.6}$, $b = 3.6$; $\rho (\text{г/см}^3)$ — плотность.

2. Решения уравнения (1) с $B \equiv 0$ изучались в [7] и более подробно в [8]. Эти исследования привели к формулировке понятий "режима с обострением" и "вспышки". Первое обусловлено видом источника: если $\beta > 1$, то у (1) существуют решения, в которых температура возмущения нарастает так быстро, что обретается бесконечность за конечный про-

межуток времени. Второе связано с наличием конкуренции между процессами выделения тепла за счет источника и его растеканием за счет теплопроводности. Если для возмущения данного размера Δr_o и данной амплитуды T_m растекание тепла не компенсируется источником, то его температура падает. Возбуждение горения в среде имеет место, когда $\Delta r_o > \Delta r_*$,

$$\Delta r_* = \pi \sqrt{\frac{2(\beta + \sigma + 1)}{\sigma(\beta - 1)}} \sqrt{\frac{k_o}{q_o}} T_m^{\frac{\sigma + 1 - \beta}{2}}, \quad (2)$$

где Δr_* — резонансная длина (РД), аналогичная критическому размеру в линейных размножающих средах [7, 8]. В этом случае сразу развивается вспышка горения, сопровождающаяся ростом температуры в "режиме с обострением". На стадии вспышки, в так называемых *S*- и *LS*-режимах горения ($\beta > \sigma + 1$) формируется "вогнутый" профиль температуры и, вследствие этого, горение оказывается локализованным на РД в течение конечного времени $\Delta t_* \approx (q_o T_m^{\beta - 1})^{-1}$ [7, 8]. В *LS*-режиме полуширина области горения сокращается со временем. В *HS*-режиме ($1 < \beta < \sigma + 1$) профиль температуры "выпуклый" и размер области горения расстет [7, 8]. В *S*-режиме ($\beta = \sigma + 1$) этот размер постоянен, а РД, в отличие от *LS*-режима, зависит только от свойств среды и не зависит от величины начального возмущения.

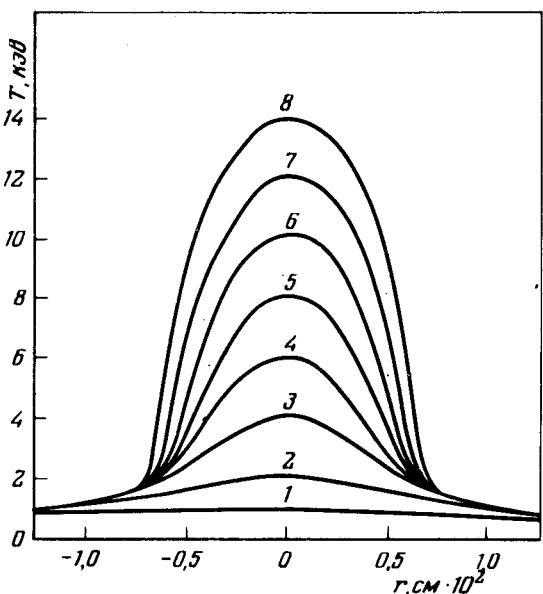


Рис. 1. Профили температуры даны на следующие моменты времени: $t = 0,0$ сек (1); $t = 3,538 \times 10^{-8}$ сек (2); $t = 3,715 \cdot 10^{-8}$ сек (3); $t = 3,728 \cdot 10^{-8}$ сек (4); $t = 3,732 \cdot 10^{-8}$ сек (5); $t = 3,735 \times 10^{-8}$ сек (6); $t = 3,737 \cdot 10^{-8}$ сек (7); $t = 3,738 \cdot 10^{-8}$ сек (8)

3. В диапазоне температур $1 - 3$ кэВ источник в (1) близок к выражению $q_o T^\beta$. Так как $\beta = 5,2 > 3,5 = \sigma + 1$, то этот источник может приводить, в соответствии с [7, 8] к локализации горения на определенной длине. При больших температурах учет члена $B T^\beta$ в знаменателе выражения для $q(T)$ в (1) приводит к изменению эффективного значения β_{eff} в записи $q(T) = q_S T^{\beta_{eff}}$. Так при $T \approx 5$ кэВ $q(T) \approx q_S T^{\sigma+1}$ с $q_S \approx 5,1 \cdot 10^6 \rho$ сек⁻¹ кэВ⁻². При $T \gtrsim 5$ кэВ $\beta_{eff} < \sigma + 1$.

Эти аппроксимации позволяют, пользуясь результатами [7, 8], получить основные характеристики ТГ в диапазоне $1 - 10$ кэв, если оно возбуждается возмущением с $\Delta r_0 \geq \Delta r_*$. Размер области локализации ТГ

$\Delta r_{\text{я}}$ дается формулой (2): $\Delta r_{\text{я}} \approx \frac{0,5}{\rho T_m^{0,85}}$ см (при изменении начальной

амплитуды в диапазоне $T_m \sim 1 - 3$ кэв). Горение локализовано в теке-

ние времени $\Delta t_{\text{я}} \approx \frac{10^{-6}}{\rho T_m^{4,3}}$ сек. При достижении в процессе горения тем-

ператур ~ 5 кэв размер и время локализации области горения опре-

деляются "S-режимом": $\Delta r_{\text{я}}^{(S)} \approx \frac{0,2}{\rho}$ см и $\Delta t_{\text{я}}^{(S)} \approx \frac{8 \cdot 10^{-8}}{\rho T_m^{2,5}}$ сек. При

далее росте температуры профиль ее внутри области локализации начинает перестраиваться из выпуклый и при $T > 10$ кэв начинает-
ся увеличение области горения.

На рис. 1 приведены результаты численного решения уравнения (1), описывающего развитие начального возмущения, заданного на длине $\approx 0,1$ см и имевшего амплитуду $T_m = 1$ кэв. Плотность $\rho = 20$ г/см³. Область вспышки имеет размер $\sim 2,5 \cdot 10^{-2}$ см. Время существования структуры ТГ $\sim 4 \cdot 10^{-8}$ сек, что тоже соответствует приведенным формулам. Заметим, что поскольку $\rho = \text{const}$ в (1) можно сделать замену независимых переменных $t' = \rho t$ и $r' = \rho r$. Тем самым, решения (1) будут одинаковыми для любых плотностей, если при увеличении сжатия в K раз уменьшить масштабы длины и времени тоже в K раз.

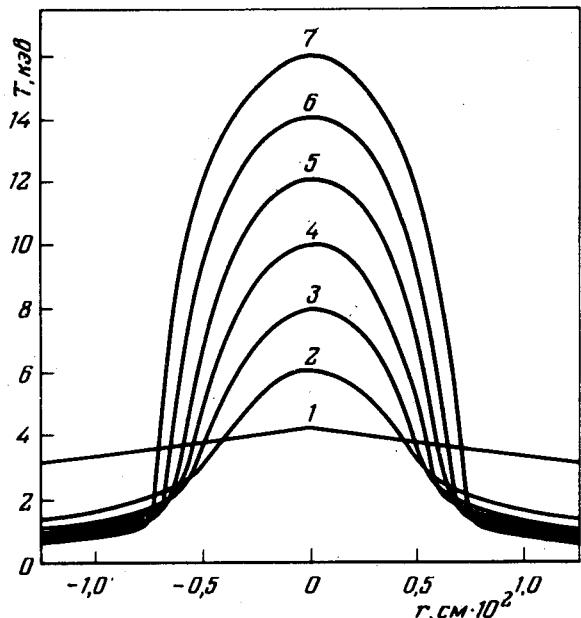


Рис. 2. Профили температуры даны на следующие моменты времени: $t = 0,0$ сек (1); $t = 3 \cdot 10^{-10}$ сек (2); $t = 3,8 \times 10^{-10}$ сек (3); $t = 4,1 \cdot 10^{-10}$ сек (4); $t = 4,3 \cdot 10^{-10}$ сек (5); $t = 4,5 \cdot 10^{-10}$ сек (6); $t = 4,7 \cdot 10^{-10}$ сек (7)

4. Оценим влияние процессов, неучтенных в предлагаемой модели.

Сравнивая величины времени релаксации ионной и электронной тем-
ператур Δt_{ei} [9] и длины пробега α -частиц Δr_α [10] с $\Delta t_{\text{я}}$ и $\Delta r_{\text{я}}$, полу-

чаем, что однотемпературное приближение и модель локального поглощения α -частиц справедливы для $T \lesssim 7 \text{ кэв}$. Вклад нейтронов можно не учитывать, так как длина их пробега Δr_n [11] велика по сравнению с $\Delta r_{\text{я}}$. Используя полученное в [6] решение, найдем, что половина термо-

ядерного горючего выгорит за время $\Delta t_{0,5} \approx \frac{8,4 \cdot 10^{-24}}{\rho < \sigma v >_{DT}} \text{ сек.}$ Из срав-

нения этого выражения с $\Delta t_{\text{я}}$ следует, что развитие горящего образования можно рассматривать без учета выгорания. Все эти оценки не зависят от плотности, потому что Δt_{ei} и $\Delta t_{0,5}$, Δr_a и Δr_n , также как и $\Delta t_{\text{я}}$ и $\Delta r_{\text{я}}$, пропорциональны ρ^{-1} .

Учет объемного излучения необходим, если длина пробега γ -квантов Δr_{γ} [9] больше размера горящей области. Вычисление показывает, что в разумных диапазонах температур (не ниже 1 кэв) и плотностей сжатия (не больше, чем в 10^4 раз) горящее образование прозрачно. Высвечивание эквивалентно добавлению в (1) стока $g(T) = g_0 T^{0,5}$, где $g_0 = 2,2 \cdot 10^8 \rho \text{ сек}^{-1} \text{ кэв}^{0,5}$ [9]. Для $T \gtrsim 3,7 \text{ кэв}$ $g(T) < q(T)$ независимо от плотности, так как и q , и g пропорциональны ρ . Если структура ТГ начинает образовываться при температурах 4 кэв, то объемное излучение уже не сможет ее загасить. На рис. 2 приведены результаты расчета с учетом потерь на объемное излучение. Начальная амплитуда возмущения $\approx 4 \text{ кэв}$, $\Delta r_0 \approx 0,1 \text{ см}$, $\rho = 20 \text{ г/см}^3$.

С другой стороны, существует диапазон плотностей, при которых горящая область является оптически плотной, а лучистая теплопроводность мала по сравнению с электронной. При $T \lesssim 7 \text{ кэв}$ это соответствует сжатиям в $\sim 10^6$ раз по отношению к плотности DT-льда. В этом случае объемного высвечивания нет.

Время разлета горящей области можно оценить как $\Delta t_s \approx \frac{\Delta r_{\text{я}}}{c_s}$,

где $c_s \approx 2 \cdot 10^7 T^{0,5} \text{ см/сек.}$ На стадии образования структуры ТГ выполнено $\Delta t_s > \Delta t_{\text{я}}$, если $T_m \gtrsim 3 \text{ кэв}$.

Учет гидродинамического движения к центру может компенсировать потери на объемное излучение в оптически прозрачной плазме при $T < 4 \text{ кэв}$.

5. Проведенное исследование показывает, что условие зажигания зависит от величины и размера начального возмущения, в частности от соотношения между размерами сжатой области в DT-мишениях и области локализации ТГ.

Расчеты аналогичные [7, 8] показывают, что для сферического случая РД примерно в полтора раза больше. Тогда критерий $\rho \Delta r_{\text{я}}$ в сферическом случае будет иметь значение $\sim 0,3 - 0,4 \text{ г/см}^2$.

Институт прикладной математики
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
3 октября 1977 г.

Литература

- [1] Сб. статей "Проблемы лазерного термоядерного синтеза". Пер. под ред. А. А. Филюкова, М., Атомиздат, 1976.
- [2] А.Ф.Настоящий, Л.П.Шевченко. АЭ, 32, 451, 1972.

- [3] S. G. Alikhanov, I. K. Konkashbaev. Nuclear Fusion, 11, 119, 1972.
 - [4] П.П. Волосевич, Л.М. Дегтярев и др. Физика плазмы, 2, 883, 1976.
 - [5] Ю.В. Афанасьев, Н.Г. Басов, П.П. Волосевич, Е.Г. Гамалий, О.Н. Крохин, С.П. Курдюмов, Е.И. Леванов, В.Б. Розанов, А.А. Самарский, А.Н. Тихонов. Письма в ЖЭТФ, 21, 150, 1975.
 - [6] Ю.В. Афанасьев, Н.Г. Басов и др. Препринт ФИАН №66, М., 1972.
 - [7] А.А. Самарский, Н.В. Змитренко и др. ДАН СССР, 227, 321, 1976.
 - [8] А.А. Самарский, Н.В. Змитренко и др. Препринт ИПМ №74, 109, М., 1976.
 - [9] Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений, М., изд. Наука, 1966.
 - [10] О.Н. Крохин, В.Б. Розанов. Квантовая электроника, №4, 10, 118, 1972.
 - [11] К.Н. Мухин. Введение в ядерную физику, М., Атомиздат, 1965.
-